® 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平4-26115

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月29日

H 01 L 21/22

Q 2104-4M R 2104-4M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

②特 願 平2-131657

②出 願 平2(1990)5月22日

@発明者 渡辺 伸吾

神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番 1 東京エレク

トロン相模株式会社内

@発明者 大加 X 亘

神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番 1 東京エレク

トロン相模株式会社内 神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番 1

⑪出 顋 人 東京エレクトロン相模

株式会社

四代 理 人 弁理士 小林 哲男

...

1. 発明の名称

模型熟処理装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1)処理ガスが接触する部分を耐熱性非金属製 反応容器で構成した模型熱処理装置において、上 記反応容器内に搬入された被処理体収納ボートを 回転する軸受部の金属部が少なくとも処理期間不 活性ガス雰囲気に設定されることを特徴とする模 型熱処理装置。
- (2)上記した不活性ガスは、処理ガスに含まれているキャリアガスと同一ガスを用いた請求項1 記載の凝型熟処理装置。
- 3. 発明の詳細な説明

「発明の目的」

【産業上の利用分野】

本発明は、擬型熱処理装置に関するものである。 【従来の技術とその課題】

半導体ウェハを拡散炉の反応容器に搬入して加

熱処理を行なう場合、縦方向に所定間隔をおいて 多数枚のウェハを搭載した処理用ポートを搬出搬 入機構を介して反応容器内に搬入し、処理用ポートを回転させながら、この容器内に処理ガスを導 入して各半導体ウェハを断面均熱状態に加熱処理 を実行すようにしている。

この処理ガスであるPOC 2,は腐食性ガスであるため、反応容器内に導入された処理ガスが接触す

る部分は、耐腐食性の材料で形成する必要がある。 そのため、処理ガスが接触する反応容器等の部分 は、非金属製の素材として、通常、石英ガラスが 用いられている。

しかし、この反応容器内に搬入した処理用ボートは上記のように回転駆動するので、この処理用ボートを軸受する軸受部は、耐荷重性並びに耐摩耗性の点から、通常、金属製の材料により形成されているため、この軸受部分が処理ガスにより腐食されるおそれがある等の課題を有していた。

本発明は、上記の実情に鑑みて開発したものであり、反応容器内に搬入した被処理体収納ポートの回転駆動用軸受部分の腐食防止を図ることを目的とした縦型熱処理装置である。

「発明の構成」

٨

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するため、本発明は、処理ガスが接触する部分を耐熱性非金属製反応容器で構成した模型熱処理装置において、上記反応容器内に搬入された被処理体収納ボートを回転する輸受

アガスと同一種類のガスを反応容器内の下方に位置している韓受部分に供給することにより不活性 雰囲気にすることができるので、反応容器内の被 処理体の処理には影響を与えないばかりでなく、 被処理体収納ボートは、金属製の韓受部分を介し て回転駆動する。

(実施例)

以下、本発明を半導体ウエハの酸化・拡散を行なう概型熱処理装置に適用した実施例につき図面 を参照して具体的に説明する。

第1回において、反応容器1は、石英ガラスに より円筒状に形成され、その軸方向を垂直方向と することにより模型無処理部を構成している。

この反応容器1の反応容器壁2の下方位置に、容器壁2から外側に突出させて一体に形成した突出筒部3より石英ガラスで形成した先端を密封した細管状のインジェクタ4を挿入し、このインジェクタ4には、多数の噴出孔5を形成している。

このインジェクタ 4 から反応容器 1 内に供給される処理ガスは、オキシ塩化りん(POC 2 ,)を含

部の金属部が少なくとも処理期間不活性ガス雰囲気に設定されるようにした。また、上記の不活性ガスは、前記の処理ガスに含まれているキャリアガスと同一ガスを用いることが好ましい。

【作用】

従って、本発明によると、多数枚の被処理体を 搭載した被処理体収納ポートを搬入搬出機構によ り反応容器に搬入し、反応容器内に処理ガスを供 給すると、容器内の被処理体は断面均熱状態に加 熱処理され、被処理体は酸化や拡散処理される。

この場合、反応容器や被処理体収納ポート等のように処理ガスが接触する部分は、非金属製の材料で形成し、被処理体収納ポートの回転駆動用軸受部分は金属で形成されている。

そこで、被処理体を処理している期間中に、この軸受部分に不活性ガスを供給すると、軸受部の 金属部分の雰囲気を不活性ガス雰囲気にすること ができるので、軸受部の金属が処理ガス中の腐食 性ガスによって腐食されることが防止できると共 に、特に、この不活性ガスを処理ガス中のキャリ

んだ O 2 、 N 2 を導入して半導体ウエハ 6 にりんドーピングを行なうようにしており、この導入される POC 2 。は腐食性ガスであり、また、反応容器 1 の周囲にはヒータ 7 を設け、反応容器 1 内を発 1 内を 200~1200 C 程度まで加熱して、酸化や拡散処理を行ない、反応容器 1 の下部には排気管 8 を設け、この排気管 8 より反応容器 1 内に導入した処理ガスを廃棄するようにしている。

この反応容器 1 内には、被処理体収納ボート 9 を図示しない関入搬出機構を介して開入または、関出させ、このボート 9 には、第 1 図に示すように 所定間隔をおいて多数枚の半導体ウエハ 6 を搭載し、加熱処理された反応容器 1 内に処理ガスを導入して半導体ウエハ 6 を酸化や拡散処理を行なうようにしている。

この場合、彼処理体収納ポートでは、駆動モータ10にベルト11を介して駆動軸12を回動可能に設け、この駆動軸12の上部に金属製の軸受部13を設け、この軸受部13に設けた石英ガラス製のポート支受部14を介して被処理体収納ポ

ート7を回転可能に設ける.

軸受部 1 3 は材質、例えばステンレススチールなどは耐荷重性の金属が用いられる。

更に、駆動輔12にはベアリング15を介して 反容器1の下方開口部16を被蓋するための石 英州の下方開口部16を被蓋すり、2000円開発をおり、2000円開発をおいる。この開閉部が成成の開閉部が成立の開閉をでは、反応を器1の開発をでは、のリップシール18を設けた供給路19(大きのでは、2000円開発をでは、2000円では、2

次に、上記実施例の作用を説明する。 多数枚の半導体ウエハ6を搭載した被処理体収納

器1内の下方に位置している軸受部13に供給することにより不活性雰囲気にすることができるため、反応容器1内の半導体ウエハ6の処理には影響を与えないばかりでなく、被処理体収納ボート9は、金属製の軸受部13を介して回転駆動することになる。

この不活性ガスの喰出量は多量に流す必要がな く、反応ガスに金属露出面が接触しないようにす ればない。

従って、不活性ガス放出のタイミングも、反応ガスの導入と同時か、早くても良いし、反応ガス 導入後でも、反応ガスが金属第出面に到達前であれば良い。

更に、不活性ガス導入の終了は、反応ガスを総 て排気後行なうのが望ましい。

軸受部 1 3 に供給するガスは不活性ガスに限らず、金属性の軸受部 1 3 に対して非腐食性のガスであり、被処理体処理ガス中に含まれているガスならばどのようなものでもよく、例えば 0 . でも良い。

ポート 9 を崩入敗出機構により反応容器 1 内に搬入し、反応容器 1 内に挿入したインジェクタ 4 より POC 2 , を供給すると、容器 1 内のインジェクタ 4 より半導体ウェハ 6 の所定間隔ごとに処理ガスが供給されてウェハ 6 は断面均熱状態に加熱処理され、ウェハ 6 には、りんドーピングがなされる。

この場合、反応容器 1 や被処理体収納ボート 9 等のように処理ガスが接触する部分は、非金属製の材料で形成し、被処理体収納ボート 9 の回転駆動用の軸受部 1 3 は金属で形成されているが、少なとも半導体ウエハ 6 を処理している期間中に、N。等の不活性ガスを供給路 1 9 より供給して流出孔 2 1 から雰囲気スペース 5 に流出させて軸受部 1 3 の金属を作ガスの混入するがスを導入する。即間、露出する表面を不活性ガスで被い保護する。

従って、軸受部13の露出する金属表面は処理 ガス中の腐食性ガスによって腐食されることから 保護できると共に、特に、この不活性ガスを処理 ガス中のキャリアガスと同一種類のガスを反応容

「発明の効果」

以上のことから明らかなように、本発明による と次のような優れた効果がある。

反応容器内に搬入した被処理体収納ボートの回 転駆動用軸受部分の腐食を防止することができる 等の効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明における模型熱処理装置の一実 施例を示した正面図、第2図は同上におえるボー トの軸受部分を示した一部拡大断面図である。

1・・・反応容器

6・・・被処理体

9・・・被処理体収納ポート

13・・軸受部・

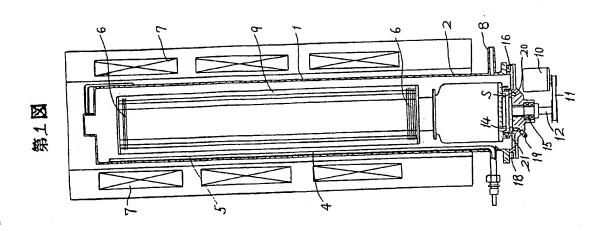
17・・被査部材

21・・流出孔

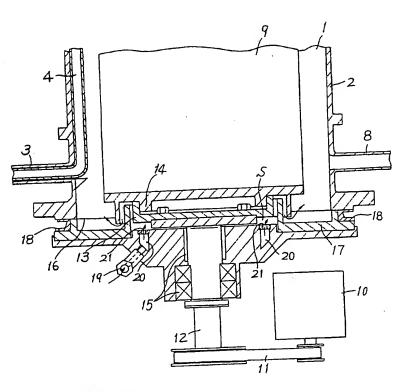
終善終 戡 薊 人 東京エレクトロン相模株式会社

代型人 弁理士 小 林 哲





第2図



Best Available Conv